

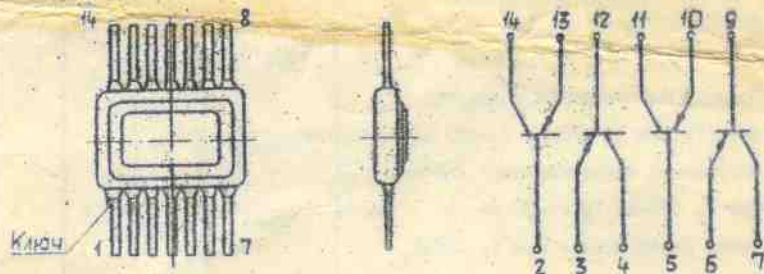


МАТРИЦЫ ТРАНЗИСТОРНЫЕ
КТС622А, КТС622Б

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-плоскостные р-п-р транзисторные матрицы КТС622А, КТС622Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в электронной аппаратуре широкого применения.

Климатическое исполнение УХЛ3.



Масса не более 0,41 г.

~

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{\text{окр.пр.}} = (+25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а			
		КТС622А		КТС622В	
		не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6
Обратный ток коллектора, мкА при $U_{\text{КВ}} = 35 \text{ В}$ $U_{\text{ЭВ}} = 35 \text{ В}$	$I_{\text{КВ0}}$		10		20
Обратный ток эмиттера, мкА при $U_{\text{ЭВ}} = 4 \text{ В}$	$I_{\text{ЭВ0}}$		20		20
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КВ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 200 \text{ мА}$, $f = 50 \text{ Гц}$	$h_{21\text{Э}}$	25	150	10	
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{\text{КВ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 30 \text{ мА}$, $f = 10^6 \text{ Гц}$	$ h_{21\text{Э}} $	2		1,5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{В}} = 80 \text{ мА}$, $I_{\text{К}} = 400 \text{ мА}$, В	$U_{\text{КЭнас}}$		1,3		2
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{\text{В}} = 80 \text{ мА}$, $I_{\text{К}} = 400 \text{ мА}$, В	$U_{\text{БЭнас}}$		2,2		2,5
Время рассасывания при $I_{\text{В}} = 20 \text{ мА}$, $I_{\text{К}} = 200 \text{ мА}$, нс	$t_{\text{рас}}$		120		200

Содержание драгоценных металлов в 1000шт. транзисторных матриц:

золото

серебро

13,3068 г
1,002 г

в том числе:

золото 0,0001305 г/мм на 14 выводах, длиной (4,0 ± 0,25) мм.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторные матрицы КТС622А, КТС622В соответствуют техническим условиям АО.336.023ТУ.

ШТАМП ОТК

27 ИЮН 1980

ЛК 498

Перепроверка произведена

дата

ШТАМП ОТК

ОТК331